Transistor PNP BC557

Codigo: **112817**

Descripción

Es un transistor compuesto por silicio, en su composición posee una placa de semiconductor con tres regiones consecutivas de diferente conductibilidad eléctrica los cuales forman dos uniones p-n-p, las dos regiones extremas tienen un mismo tipo de conductibilidad, la intermedia, conductibilidad de otro tipo, estas son llamadas emisor, colector y base.

- La estructura de transistor: pnp
- Máxima disipación de potencia continua colector del transistor (Pc): 625mW
- Limite el colector DC-base (Ucb): 50V
- Límite de colector-emisor del transistor de tensión (Uce): 45V
- Límite de tensión emisor-base (Ueb): 5V
- Máxima corriente continua de colector del transistor (Ic max): 100mA
- Temperatura límite de unión pn (Tj): 150°C
- Frecuencia de corte de la relación de transferencia corriente del transistor (Ft): 150MHz
- Capacidad de la unión de colector (Cc), Pf: 20